科学研究費助成事業

平成 29 年 6 月 3

研究成果報告書



平成 2 9 年 6 月 3 日現在
機関番号: 14301
研究種目: 基盤研究(B) (一般)
研究期間: 2014~2016
課題番号: 26289288
研究課題名(和文)粉体の瞬間精密電荷制御を可能にする気相単極イオン抽出法の開発と帯電粒子の運動解析
研究課題名(英文)Development of unipolar ion extraction method for instantaneously controlling charge of powder and dynamic analysis of charged particles
研究代表者
松坂 修二(Matsusaka, Shuji)
京都大学・工学(系)研究科(研究院)・教授
研究者番号:1 0 2 1 9 4 2 0

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 12,700,000円

研究成果の概要(和文):大気圧プラズマジェットから生成される電荷を利用して粒子表面の電荷を制御する方 法を実験的に検討した、石英ガラス管に電極を取り付けて交流電圧および直流パイアス電圧を印加し、ヘリウム ガスを供給して大気圧プラズマジェットを生成した、直流パイアス電圧の値を変えることにより、プラズマ中の 正イオンや電子を選択的に抽出できた、粒子をプラズマジェット中で重力落下させる実験と静置した粒子にプラ ズマジェットを照射する実験を行い、いずれも空間電荷に基づく電場によって正イオンや電子を粒子に付与でき ることがわかった、また、外部電場の印加によっても粒子の帯電を制御できた、これらの実験結果をもとに粒子 の帯電機構を考察した。

研究成果の概要(英文): A method for controlling electrostatic charge on particles with electric charges generated by an atmospheric pressure plasma jet was studied experimentally. The atmospheric pressure plasma jet was generated by applying AC voltage and DC bias voltage to an electrode in a quartz glass tube with helium gas flow. By changing the value of the DC bias voltage, positive ions and/or electrons could be extracted from the plasma. Two experiments, one in which particles were allowed to fall in the plasma jet and the other in which particles were irradiated with the plasma jet, were performed, and the experimental results showed that both methods allowed the particles to acquire positive ions and/or electrons because of the electric field caused by the space charge. In addition, particle charging could be controlled by applying an external electric field. Based on these experimental results, the particle charging mechanism involved was discussed.

研究分野:化学工学

キーワード: 粉体 粒子 プラズマ 帯電 電荷

1. 研究開始当初の背景

粒子の高精度配列,積層化をはじめとする 粒子の位置制御に関する応用技術は,材料の 高機能化・集積化のための革新的技術として, 現在,多くの産業で注目されている。粉体・ 粒子を所定の位置まで移動させて高精度で 配置するには,粒子を凝集させることなく分 散させた状態で操作しなければならない。粒 子に触れることなく,遠隔処理で正確に粒子 の運動を制御するには,従来行われてきたバ ルクハンドリングの手法では限界があり, 個々の粒子の運動に着目して,新しい技術を 開発しなければならない。

粒子を液中で取り扱うと、粒子の分散は比 較的容易であるが、洗浄、乾燥、廃液処理が 必要であり、工程数の増加とともに異種物質 の混入の可能性が増えるので、付加処理を必 要としない気相粒子の精密ハンドリングに 期待が寄せられている。

工業的利用を考えると、機能性に加えて実 用性が不可欠であり、多数の粒子を一度に処 理する必要がある。具体的には、電場、磁場、 音場などの利用が効果的と考えられている が、遠隔制御性、汎用性を総合的に評価する と、粒子に電荷を付与し、電場によって粒子 の運動を制御する方法が最も効果的と考え られる。電場の制御は高い精度で行えるが、 粒子への電荷の付与と粒子の挙動に関する 基礎現象の解明が遅れているので、この領域 の基盤研究の進展が技術革新の鍵を握る。

粒子への電荷の付与と制御は,接触帯電法 とイオン荷電法とに大別できる。前者は,異 種物質との接触による電荷移動を利用して おり (Matsusaka et al., 2007),仕事関数に起 因する接触電位差が基本的な駆動源になる。 電荷を精密に制御するには,外部電界を利用 して有効接触電位差を制御する必要がある (Bunchatheeravate et al., 2013; Mizutani et al., 2013)。

一方,イオン荷電法は,粒子に対して電荷 を瞬時に付与できるという特長をもつが,既 存の技術では沿面放電等を利用しており,電 極で囲まれた空間(閉鎖系)で使用しなけれ ばならないので操作上の制限が多い。したが って,粒子に電荷を付与する場が閉鎖系では なく解放系であり,瞬時に粒子を正あるいは 負に任意の割合で帯電させられれば,新しい 粒子帯電技術(すなわち,分野横断型基盤技 術)となりうる。

大気圧プラズマジェットを用いると,正イ オンや電子を容易かつ多量に生成でき (Schütze et al., 1998; Massines et al., 2012),電 荷の生成機構も解明されてきているので (Teschke et al., 2005; Lu and Laroussi, 2006; Walsh et al., 2010; Lu et al., 2012, 2014),プラズ マ中の電荷を応用した技術の展開に期待が 高まるが,大気圧プラズマジェットから任意 の電荷を抽出して粒子に電荷を付与し,粒子 の帯電を制御する方法は開発されていない。 2. 研究の目的

本研究では、プラズマジェットを自由空間 に生成させて、単極イオンあるいは電子を抽 出し、粒子に電荷を精密かつ速やかに付与す る技術を開発することを目的とする。電荷を 付与するプラズマジェット装置を設計・製作 し、単極イオンの生成条件を明らかにしたの ち、粒子を供給して帯電粒子の動的挙動を解 析するとともに、帯電制御を決定するパラメ ータを定量的に解析・評価して、粒子帯電シ ステムを構築する。

研究の方法

(1) 単極荷電用大気圧プラズマジェット装置および操作条件の検討

① 大気圧プラズマジェット装置の試作

Fig.1 に、大気圧プラズマジェット装置の 基本構成を示す。希ガスには、大気圧プラズ マジェットの生成に有利なヘリウムガスを 使用し,マスフローコントローラーでガス流 量を制御した。電極に印加する電圧は、ファ ンクションジェネレータの出力信号を高電 圧アンプで増幅した。自由空間における電荷 の生成量を評価するために、プラズマジェッ トの中心軸上,石英ガラス管の出口から 50 mm 離れた位置に微小電極(外径 2 mm,長 さ8 mm)を配置し、アースに流れる単位時 間あたりの電荷(すなわち、検出電流)をエ レクトロメータで測定した。大気圧プラズマ ジェットの生成部として, 電極の形状や配置 が異なる多数の大気圧プラズマジェット装 置が提案されて各種実験で使用されている が (Lu et al. (2012), 本研究では, 2 種類の代 表的大気圧プラズマジェット装置を試作し, 単極荷電装置への適用性を検討した。



Fig. 1 Experimental setup for generating atmospheric pressure plasma jet

 2 大気圧プラズマジェット生成部の構造の 検討

Fig. 2 に, 2 種類の大気圧プラズマジェット 生成部の構造を示す。ひとつは内径 8 mm, 外径 10 mm の石英ガラス管の外側に円筒電 極(銅箔:内径 10 mm,長さ 50 mm)を取り 付けた構造であり,もうひとつは石英ガラス 管の内側に円筒電極(銅管:内径 6 mm,外 径 8 mm,長さ 50 mm)を組み込んだ構造で ある。



Fig. 2 Atmospheric pressure plasma jet devices: a. outer electrode system, b. inner electrode system

単極荷電に適した大気圧プラズマジェッ ト装置の構造を検討するため、周波数 6 kHz、 振幅 5 kV の正弦波交流電圧に直流バイアス 電圧 +5 kV を加えて, 電圧が 0-10 kV の範 囲で周期変動するように設定したのち、ヘリ ウムガスを1 SLM (標準状態 0 °C, 1 atm, 1 L/min) で供給した。試作したふたつの装置で 安定した紫色のプラズマジェットが生成さ れたが,石英ガラス管の外側に電極を配置し た場合,検出電流が +8 nA であったのに対 し、内側に電極を配置すると +400 nA の値 が得られた。前者では、印加した直流バイア ス電圧の効果がほとんどみられなかったが, 後者では、バイアス電圧の印加によって十分 に大きい電流が測定された。ヘリウムガスが 電極と接する構造では、プラズマジェット中 の電子が、電極(正極)にすぐに引き戻され るので、自由空間には正イオンが多くなった と考えられる。すなわち、単極荷電に適した 大気圧プラズマジェット装置は、電極を内側 に配置して直流バイアス電圧を印加できる 構造といえる。

③ 単極荷電抽出法の検討

Fig. 3 に、検出電流におよぼす直流バイア ス電圧の影響を示す。印加した正弦波交流電 圧の周波数は6 kHz、振幅は5 kV であり、直 流バイアス電圧を -5 kV から +5 kV の範 囲で変えると検出電流は負から正まで連続 して変化した。負のバイアス電圧を印加する とプラズマ中の正イオンが電極に引き戻さ れるので、自由空間には電子が過剰に存在し、



Fig. 3 Effect of DC bias voltage on space charge

バイアス電圧の符号を変えると,正イオンが 過剰に存在するようになる。その割合は,直 流バイアス電圧の大きさに依存するので,大 気圧プラズマ中の電荷の濃度を直流バイア ス電圧によって調節できる。

Fig. 4 に、ヘリウムガスの流量を変えて得られたプラズマジェットの画像を示す。正弦 波交流電圧の周波数は 6 kHz,振幅は 5 kV, 直流バイアス電圧は +5 kV で一定にした。 ヘリウムガスの流量が 1 SLM のとき,紫色 のプラズマジェットの長さは 20 mm 程度で あり、ジェットの先端は細くなっているが、 ヘリウムガスの流量を多くするとプラズマ ジェットは長く伸び、10 SLM ではプラズマ ジェットは長く伸び、10 SLM ではプラズマ ジェットは 80 mm に達した。ただし、ヘリ ウムガスの流量を多くすると周囲の空気を 乱すので、過剰な条件設定は避けるべきであ る。

Fig. 5 に、ヘリウムガスの流量を1 および 5 SLM に設定し、微小電極の位置を変えて測 定したプラズマジェット周辺の検出電流を



Fig. 4 Photographs of atmospheric plasma jets with different flow rates of helium gas ($f_{AC} = 6$ kHz, $V_{AC} = 5$ kV, $V_{DC} = +5$ kV)



Fig. 5 Two-dimensional distribution of detected currents $(f_{AC} = 6 \text{ kHz}, V_{AC} = 5 \text{ kV}, V_{DC} = +5 \text{ kV})$

二次元分布として示す。プラズマジェットの 周囲の検出電流は、距離が離れるほど低下し た。また、ヘリウムガスの流量を多くすると プラズマジェットの検出電流は大きくなり、 気流の方向に電荷の分布が伸びることもわ かった。以上の実験結果を基にして、本研究 における単極荷電用大気圧プラズマジェッ トの生成条件は、周波数6kHz、振幅5kVの 正弦波交流電圧を標準とし、直流バイアス電 圧は ±5kV の範囲で変更することにした。 また、ヘリウムガスの流量は1SLM を標準 とすることにした。

(2) 大気圧プラズマジェットによる粒子帯 電実験

実験装置および方法

Fig. 6に,大気圧プラズマジェットを用いた粒子帯電実験装置の概略構成を示す。内径6mm,外径8mm,長さ110mmの円筒電極(銅管)を内径8mm,外径10mmの石英ガラス管内に組み込んだ。円筒電極の終端と石英ガラス管の出口までの距離は40mmで一定とし,ヘリウムガスが水平に排出されるようにプラズマジェット生成部を配置した。

粒子は、振動フィーダーを用いて少流量 (30 mg/s 以下) で2分間供給し、 プラズマジ ェット内を重力落下した粒子を平板上に堆 積させた。粒子の電荷が平板を介して漏洩し ないように、平板には誘電体(厚さ1mmの アクリル板)を使用し、外部電場の影響を防 ぐために、平板は接地した金属板の上に置い た。平板上に堆積した粒子の電荷は、吸引式 ファラデーケージを使用して測定した。また, プラズマジェット内を粒子が通過しない条 件でも実験を行った。すなわち、円筒電極に 電圧を印加しない状態で粒子を2分間供給し 重力落下によって粒子を堆積させたのち、円 筒電極に電圧を印加してプラズマジェット を2分間生成し、粒子の電荷を吸引式ファラ デーケージで測定した。

使用した粒子は、マンガンフェライト(質量規準中位径 $D_{p50} = 79 \ \mu m$ 、体積抵抗率 $\rho_p = 7.6 \ \Omega \cdot m$)、アクリル樹脂で被覆したマンガンフェライト ($D_{p50} = 81 \ \mu m$ 、 $\rho_p = 2.8 \times 10^3 \ \Omega \cdot m$)、アルミナ ($D_{p50} = 51 \ \mu m$ 、 $\rho_p = 7.1 \times 10^7 \ \Omega \cdot m$)の



Fig. 6 Experimental setup for particle charging by atmospheric pressure plasma jet

3 種類であり、電気抵抗はそれぞれ大きく異 なる。

粒子帯電実験の結果および考察

Fig. 7 に、粒子の表面電荷密度におよぼす プラズマジェットの中心軸と平板までの距 離の影響を示す。直流バイアス電圧として +5 kV を印加した結果, 粒子は正に帯電した。 プラズマジェット内に粒子を重力落下させ ると(実線),プラズマジェット内に粒子を 通過させない場合(破線)に比べて、粒子の 電荷は大きくなったが、いずれの場合におい ても,平板をプラズマジェットから遠ざける と粒子の帯電量は小さくなった。すなわち, プラズマジェット内に粒子を通過させるこ とが粒子の帯電の必須条件ではなく、プラズ マジェットの中心軸と平板までの距離が粒 子の電荷を決める主要因子といえる。平板を プラズマジェットに近づけると, 空間中の電 荷の濃度は大きくなるので、帯電の進行も速 くなるが、プラズマジェットは2分間照射し ているので粒子の帯電に帯電速度の影響は 現れず、平衡帯電を考えればよい。

本実験では、平板は接地した金属板の上に 置いているので、正イオンは電場内の電気力 線に沿って移動し、粒子に到達することにな る。また、平板および金属板をプラズマジェ ットに近づけるほど、空間電荷に起因する電 界強度は大きくなる。粒子の帯電がいわゆる 電界荷電によるものと考えると、粒子の平衡 帯電は電界強度とともに増加するので、平板 をプラズマジェットに近づけるほど粒子の 電荷は増加することになる。なお、個々の粒 子が重力落下する過程で生じる電界荷電の 方が、堆積粒子層を帯電させる場合に比べて、 粒子表面を十分に帯電させる可能性が高く、 この差が実験結果に表れたと考えられる。

Fig. 8 は、プラズマジェットの中心軸と平 板までの距離を一定にし(30 mm)、直流バイ アス電圧を変化させて得られた粒子帯電の 結果である。粒子をプラズマジェット中に落 下させる方が、帯電量(絶対値)は大きくな るが、直流バイアス電圧の値を変えることに よって、粒子の電荷の符号および帯電量を制 御できることがわかった。直流バイアス電圧



Fig. 7 Effect of distance between plasma jet and plate on particle surface charge density



Fig. 8 Effect of DC bias voltage on particle surface charge density



Fig. 9 Effect of external voltage on particle surface charge density

を変えると自由空間の電荷の濃度が変化し, これにともなって電界強度が変わるので,帯 電量が変化したと考えられる。すなわち,直 流バイアス電圧による粒子帯電の制御も,上 で述べた電界荷電によって説明できる。

電界荷電は外部電場によって制御するこ とも可能なはずである。平板下部の金属板を 接地する代わりに電圧を印加し、粒子をプラ ズマジェット中に落下させずに堆積させた のち、プラズマジェットによって生成した電 荷を2分間、粒子に照射する実験を行った。

Fig. 9 に、粒子の電荷におよぼす外部電場の影響を示す。金属板に印加する電圧を±10 kV の範囲内で変えると、粒子の電荷の符号および値が大きく変化しており、粒子の帯電は外部電場によって制御できることが検証された。さらに、プラズマジェットのバイアス電圧を+5 kV あるいは -5 kV に変更すると空間に生成される正イオンや電子の濃度が変化するので、空間の電場も変わることになる。空間の電荷によって形成される電場と外部電場の向きが逆で強度が同じ場合、電荷の移動は停止する。

Fig. 10 異なる材質(マンガンフェライト, アクリル樹脂で被覆したマンガンフェライ ト,アルミナ)の粒子を用いて行った帯電実 験の結果である。ここでは,操作条件として 直流バイアス電圧を変化させたが,同図から わかるように,粒子の表面電荷密度におよぼ す直流バイアス電圧の影響は同様であり,プ ラズマジェットよって生成される正イオン



Fig. 10 Particle surface charge density for different materials

や電子を用いて粒子の電荷を制御すること は可能といえる。

4. 研究成果

単極荷電用大気圧プラズマジェット装置 を設計・製作し,基礎特性を評価した結果, プラズマジェット生成部は,石英ガラス管の 内側に円筒電極を取り付ける構造が適して いることがわかった。正弦波交流電圧として 6 kHz,振幅 5 kV を印加し,ヘリウムガスを 1 SLMで供給すると紫色のプラズマジェット が生成され,直流バイアス電圧の符号および 大きさを変更すると大気圧プラズマ中の電 荷を負から正まで連続して変更できた。すな わち,直流バイアス電圧によって大気圧プラ ズマジェット中の正イオンや電子を選択的 に抽出できた。

次に,大気圧プラズマジェットを用いた粒 子帯電実験装置を製作して実験的検討を行 い,プラズマジェットで生成した正イオンや 電子を利用して粒子に任意の極性の電荷を 適切な割合で付与する方法を開発した。粒子 の帯電機構は電界荷電が支配的であり,直流 バイアス電圧を制御する方法と外部電場を 制御する方法を併用すると設定の自由度が さらに高くなることを明らかにした。

<引用文献>

- Bunchatheeravate, P., J. Curtis, Y. Fujii and S. Matsusaka; "Prediction of Particle Charging in a Dilute Pneumatic Conveying System," AIChE J., 59, 2013, 2308–2316
- ② Lu, X. and M. Laroussi; "Dynamics of an Atmospheric Pressure Plasma Plume Generated by Submicrosecond Voltage Pulses," J. Appl. Phys., 100, 2006, 063302
- ③ Lu, X., M. Laroussi and V. Puech; "On Atmospheric-Pressure Non-Equilibrium Plasma Jets and Plasma Bullets," Plasma Sources Sci. Technol., 21, 2012, 034005
- (4) Lu, X., G.V. Naidis, M. Laroussi and K. Ostrikov; "Guided Ionization Waves: Theory and Experiments," Phys. Rep., 540, 2014, 123–166
- (5) Massines, F., C. Sarra-Bournet, F. Fanelli, N.

Naudé and N. Gherardi; "Atmospheric Pressure Low Temperature Direct Plasma Technology: Status and Challenges for Thin Film Deposition," Plasma Process. Polym., 9, 2012, 1041–1073

- (6) Matsusaka, S., M. Oki and H. Masuda; "Control of Electrostatic Charge on Particles by Impact Charging," Adv. Powder Technol., 18, 2007, 229–244
- ⑦ Mizutani, M., K. Takeda, M. Yasuda and S. Matsusaka; Characterization of Particles Triboelectrically Charged by a Two-Stage System using Vibration and External Electric Fields, Journal of the Society of Powder Technology, Japan, 50, 2013, 832-839
- (8) Schütze, A., J. Y. Jeong, S. E. Babayan, J. Park, G. S. Selwyn and R. F. Hicks; "The Atmospheric-Pressure Plasma Jet: A Review and Comparison to Other Plasma Sources," IEEE Trans. Plasma Sci., 26, 1998, 1685–1694
- ⑨ Teschke M., J. Kedzierski, E. G. Finantu-Dinu, D. Korzec and J. Engemann; "High-Speed Photographs of a Dielectric Barrier Atmospheric Pressure Plasma Jet," IEEE Trans. Plasma Sci., 33, 2005, 310–311
- Walsh, J. L., F. Iza, N. B. Janson, V. J. Law an M. G. Kong; "Three Distinct Modes in a Cold Atmospheric Pressure Plasma Jet," J. Phys. D: Appl. Phys., 43, 2010, 075201
- 5. 主な発表論文等
- 〔雑誌論文〕(計6件)
- 北嶋士郎,安田正俊,<u>松坂修二</u>;「大気圧プ ラズマジェット電荷抽出法による誘電板 上移動粒子の表面電荷の制御」,化学工学 論文集,査読有,43,2017,16-21 https://www.jstage.jst.go.jp/article/kakoronbu nshu/43/1/43 16wh036/ article/-char/ja/
- <u>松坂修二</u>,野口敦史,北嶋士郎,安田正俊; 「大気圧プラズマジェットを利用したイ オン/電子照射による粉体層の荷電」,化 学工学論文集,査読有,42,2016,137–141 https://www.jstage.jst.go.jp/article/kakoronbu nshu/42/4/42_16wh020/_article/-char/ja/
- <u>松坂修二</u>,野口敦史,北嶋士郎,安田正俊; 「大気圧プラズマジェットによる粒子表 面電荷の制御」,化学工学論文集,査読有, 42,2016,100–106 https://www.jstage.jst.go.jp/article/kakoronbu nshu/42/3/42_15wh058/_article/-char/ja/
- ④ Techaumnat, B. and <u>S. Matsusaka</u>; "Effect of Charge Transfer on Electrostatic Adhesive Force under Different Conditions of Particle Charge and External Electric Field," Powder Technology, 査読有, 301, 2016, 153–159 http://www.sciencedirect.com/science/article/ pii/S0032591016303461
- (5) Mizutani, M., M. Yasuda and <u>S. Matsusaka</u>; "Advanced Characterization of Particles"

Triboelectrically Charged by a Two-Stage System with Vibrations and External Electric Fields, Advanced Powder Technology," 査読 有, 26, 2015, 454–461 http://www.sciencedirect.com/science/article/ pii/S0921883114003148

- ⑥ Matsusaka, S., D. Wei, M. Yasuda and S. Sasabe; "Adhesive Strength Distribution of Charged Particles on Metal Substrate in External Electric Field," Advanced Powder Technology, 査読有, 26, 2015, 149–155 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921883114002350
- 〔学会発表〕(計7件)
- ① <u>松坂修二</u>;「大気圧プラズマジェットによる粒子の帯電」,粒子帯電制御研究会(招待講演)2016年9月2日,同志社大学烏丸キャンパス
- ② 松坂修二,北嶋士郎,安田正俊;「粒子の帯 電制御用大気圧低温プラズマジェットの 開発」,粉体工学会春期研究発表会,2016 年5月17~18日,京都リサーチパーク
- ③ 松坂修二,野口敦史,北嶋士郎,安田正 俊;「大気圧プラズマジェットによる粒子 表面電荷の制御」,化学工学会第81年会, 2016年3月13~15日,関西大学千里山キ ャンパス
- ④ 北嶋士郎,安田正俊,<u>松坂修二</u>;「大気圧プ ラズマジェットを用いた粒子帯電機構の 解明」,粉体工学会秋期研究発表会,2015 年 10 月 13~14 日,大阪南港 ATC コンベ ンションルーム
- ⑤ <u>Matsusaka, S.</u>; "Characterization of particles triboelectrically charged in external electric field," STEP-1 (招待講演) 2014 年 12 月 20 日, Soka University
- ⑥ <u>松坂修二</u>;「付着,流動,静電気の特性評価 と粉体ハンドリングへの応用」,NEPTIS-23(招待講演)2014年12月19日,ステー ションコンファレンス東京
- ⑦ 野口敦史,安田正俊,松坂修二;「大気圧低 温プラズマジェットを利用した粒子の帯 電現象」,粉体工学会秋期研究発表会, 2014年11月25~26日,東京ビッグサイト
- [その他]
- 京都大学学術情報リポジトリ
- https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/h andle/2433/217406
- ② https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/h andle/2433/217405
- ③ https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/h andle/2433/224939

6. 研究組織

- (1)研究代表者
 - 松坂 修二(Matsusaka, Shuji) 京都大学・大学院工学研究科・教授

 - 研究者番号:10219420